

第2卷 第2期
1981年5月

半 导 体 学 报
CHINESE JOURNAL OF SEMICONDUCTOR

Vol. 2, No. 2
May, 1981

全国半导体激光器和发光器件学术讨论会

中国电子学会委托中国科学院半导体研究所、永川光电技术研究所、长春半导体厂共同筹办的《全国半导体激光器和发光器件学术讨论会》于1980年12月12日至16日在永川光电技术研究所举行。参加这次会议的有特邀代表高鼎三、冯志超教授、杨姮彩高级工程师，有来自全国科研单位、高等院校、工业部门等36个单位，98名代表。

大会共收到学术报告62篇。这些学术报告基本上反映了我国目前半导体激光器和发光器件的研究情况。学术水平较以前有了提高，器件物理研究工作普遍有了加强和深入，器件测试研究也很活跃，反映了我国半导体激光器和发光器件的研究无论在深度和广度上都有了新的发展，如开展了俄歇分析、X光形貌研究、利用瞬态电容谱仪研究半导体中的深能级及其对器件性能的影响、微区光学测量、晶体缺陷对于器件性能的关系、异质结界面的控制和界面物理的研究等。会议还组织了三元系激光器的寿命和退化的问题；四元系激光器的制造、测试和发展问题；器件物理问题等专题讨论，并就今后如何更好地开展这方面的工作组织了座谈讨论，提出了一些意见和建议。代表们认为这次会议开得是好的、及时的，达到了交换学术思想、交流经验、互相学习的目的，相信对今后我国半导体激光器和发光器件的研究将起积极的促进作用。

(唐 顾)

National Symposium on Semiconductor Lasers and LEDs

Sichuan, Yongchuan Dec. 12—16, 1980